

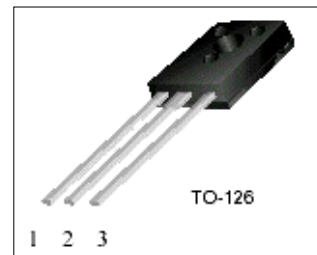
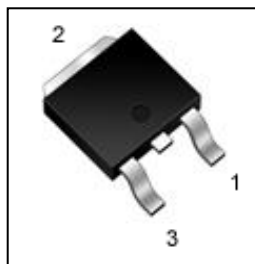
**КТ972А÷Г**

**NPN КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО – ПЛАНАРНЫЙ ВЧ СОСТАВНОЙ ТРАНЗИСТОР**

**оАО. 336.452 ТУ**

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В АППАРАТУРЕ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

- \* Зарубежный аналог КТ872А – **BD875**
- \* Изготавливается в корпусе **КТ-27 (ТО-126)**, **КТ-89 (ДРАК)**
- \* Комплементарная пара – **КТ973 А ÷Г**



**1 – эмитт. 2 –колл. 3 – база**

**1 ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Параметры	Обозначение	Ед измер.	Значение
Напряжение коллектор-база КТ972А, В, Г КТ972Б	Укб max	В	60 45
Напряжение коллектор-эмиттер (Rбэ = 1 кОм) КТ972А, В, Г КТ972Б	Укэг max	В	60 45
Напряжение эмиттер-база	Уэб max	В	5
Постоянный ток коллектора	Ik max	А	2
Импульсный ток коллектора (tu ≤10 мкс, Q ≥ 5)	Iки max	А	4
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Tкорп. = -45 ÷ +25 °С	Pк max	Вт	8
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Tсреды. = 25 °С	Pк max	Вт	1.25
Температура перехода	Tj max	°С	150

**ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ( Tокр.ср.=25°С )**

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Обратный ток коллектор-эмиттер КТ972А, В КТ972Б, КТ972Г	Ikэг	мА	Uкэ = 60В, Rэб = 1 кОм Uкэ = 45В, Rэб = 1 кОм Uкэ = 60В, Rэб = 1 кОм		1.0 1.0 0.3
Статический коэффициент передачи тока КТ972А, Б КТ972В, Г	h <sub>21E</sub>		Uкб = 3 В, Iэ = 1 А, f = 50 Гц	750 750	- 5 000
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер КТ972А, Б, В КТ972Г	Uкэ(нас)	В	Iк = 500 мА, Iб = 50 мА		1.5 0.95
Напряжение насыщения база-эмиттер КТ972А, Б, В КТ972Г	Uбэ(нас)	В	Iк = 500 мА, Iб = 50 мА		2.5 1.7
Время -рассасывания	trас.	нс	Iб1= Iб2= 50 мА, Q ≥ 50 Iк = 500 мА, tu=30 мкс,		200

**220108, г.Минск, ул. Корженевского, 16, УП "Завод ТРАНЗИСТОР"**  
**Отдел маркетинга: тел./факс (10-37517) 212-59-32**  
**E-mail:market@transistor.com.by; http://www.transistor.by**